

CDBA GERÇEKLEMESİ VE BASAMAKLI TÜRDEN LC DEVRE SIMÜLASYONU

Umut E. AYTEN¹

Herman SEDEF²

^{1,2}Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi, 34349, Yıldız, İstanbul

¹e-posta:ayten@yildiz.edu.tr

²e-posta: sedef@yildiz.edu.tr

Anahtar sözcükler:Aktif Filtreler, Akım Modlu Devreler, Gerilim Izleyicili Akım Farkı Kuvvetlendirici

ABSTRACT

Recently current differencing buffered amplifier (CDBA) is introduced and many publications are given to show its versatility and advantages. Therefore, in this paper, CDBA element is realized using 1.5 μ YITAL CMOS parameters. In addition to this, an application example is given in order to shows CDBA performance.

1. GİRİŞ

1999 yılında Acar ve Özoguz [1] tarafından, devre sentezinde yeni imkanlar sağlamak ve devre kuruluşunu basitleştirmek için, gerilim izleyicili akım farkı kuvvetlendiricisi (CDBA) aktif elemanı tanıtılmıştır. Bu aktif eleman kullanılarak literatürde, genelleştirilmiş empedans çevirici, negatif empedans çevirici, tamamen tümlenmiş işaret işleme devreleri [2], akım modlu filtreler [2-9], gerilim modlu filtreler [1,10-12], basamaklı türden LC devre simülörleri [9], direnç kontrollü sinüsoidal osilatörler [13] ve tamamen tümlenmiş jiratör devresi [14] gibi devreler gerçekleştirilmiş ve bunların gerilim ve akım modlu analog işaret işleme uygulamaları için oldukça kullanışlı olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda söz edilen çalışmalarında üç tip CDBA gerçeklemesine rastlanmıştır. Birinci tip gerçeklemede ticari olarak üretilen AD844 akım geri beslemeli kuvvetlendirici(CFA) elemanı kullanılmaktadır [1]. İkinci tip gerçeklemede MOS transistörler [2,8,10,12], üçüncü tip gerçeklemede ise bipolar transistörler kullanılmıştır [9]. Rastlanan çalışmalar içinde Tarım ve Kuntman'ın [12] sunmuş olduğu topolojinin giriş ve çıkışları için transfer fonksiyonuna ilişkin band genişliği 70MHz, giriş dirençleri $Z_p = Z_n = 645\Omega$, çıkış dirençleri $Z_w = 49\Omega$, $Z_z = 678\text{ M}\Omega$ olarak belirtilmiştir [12]. Tangsrat ve

Surakampontorn'nun çalışmasında bipolar tranzistörler kullanılmıştır ve sunulan topolojinin giriş ve çıkışları için transfer fonksiyonuna ilişkin band genişliği 1GHz, giriş dirençleri $Z_p = Z_n \cong 0\Omega$, çıkış dirençleri $Z_w \cong 180\Omega$, $Z_z \cong 10\text{ M}\Omega$ olarak belirtilmiştir [9].

Bu çalışmada TÜBİTAK YİTAL 1.5 μ parametreleri kullanılarak geniş bandlı MOS CDBA devresi gerçekleştirilmiş ve performans analizi SPICE programından yararlanarak yapılmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen CDBA elemanı kullanılarak duyarlılık davranışları iyi olduğu bilinen giriş ve çıkış direnç elemanı ile sonlandırılmış basamaklı türden LC devresinin simülasyonu yapılmıştır.

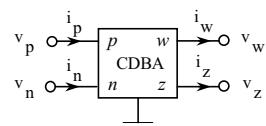
2. CDBA ELEMANININ GERÇEKLENMESİ

CDBA, beş ucu aktif devre elemanıdır ve simbolü Şekil-1'de verilmiştir. Bu uçlardan biri referans olmak üzere, iki uc giriş (p, n) ve iki uc ise (z, w) çıkış olarak kullanılmaktadır. İdeal olmayan CDBA'nın uc karakteristikleri eşitlik (1) ile tanımlanır.

$$i_z = \alpha_p i_p - \alpha_n i_n, \quad v_n = 0, \quad v_p = 0, \quad v_w = \mu v_z \quad (1)$$

Burada α_p , α_n ve μ sırasıyla akım ve gerilim kazançlarıdır ve $\alpha_p = 1 - \varepsilon_p$, $\alpha_n = 1 - \varepsilon_n$, $\mu = 1 - \varepsilon_v$ şeklinde ifade edilirler. Burada ε_p ve ε_n akım izleme hatalarını belirtmektedir. Aynı şekilde ε_v de gerilim izleme hatasını göstermektedir. CDBA elemanında p ve n uçları akım girişli ve w ve z uçları ise sırasıyla gerilim ve akım çıkışlıdır. İdeal şartlarda, p ve n uçları sıfır giriş empedanslı, w ucu sıfır ve z ucu

ise sonsuz çıkış empedansı gösterir. İdeal şartlarda $\alpha_p = \alpha_n = \mu = 1$ 'dir.



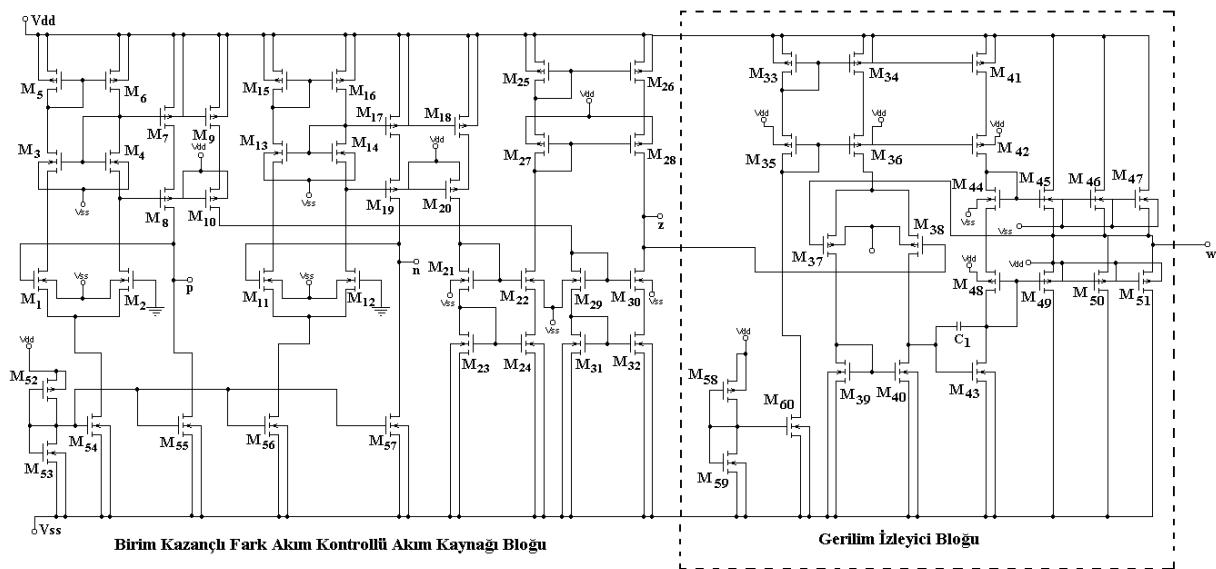
Sekil-1. CDBA Elemanın Sembolü

Bu çalışmada gerçekleştirilen CDBA elemanı Şekil-2'de verilmiştir. CDBA temel olarak iki bloktan oluşur. Bu bloklardan biri birim kazançlı akım farkı kuvvetlendirici, diğeri ise gerilim izlevicisidir.

CDBA elemanını oluşturan MOS'ların kanal genişlikleri (W) ve uzunlukları (L) Tablo-1'de verilmiştir. Devrenin besleme gerilimi $V_{dd} = -V_{ss} = 3$ V'tur. CDBA elemanında harcanan ortalama güç 91.8 mW 'tır.

akım değerleri %1 hata payı ile $750\mu\text{A} \leq I_z \leq 800\mu\text{A}$ sınır değerleri içinde lineer olarak değiştiği görülmüştür. Aynı şekilde $I_p = 0\text{A}$ yapılarak I_z akımının I_n 'ye göre değişimi incelenmiştir. Bu koşul altında z ucunun akım değerlerinin %1 hata payı ile $800\mu\text{A} \leq I_z \leq 750\mu\text{A}$ sınır değerleri içinde lineer olarak değiştiği görülmüştür. I_z akımının I_p ve I_n 'ye göre değişimi Şekil 3'te verilmiştir. Aynı şekilde z ucuna ilişkin gerilimlerin $-1.45V \leq V_z \leq 1.45V$ ve w ucuna ilişkin gerilimlerin $-1.4V \leq V_w \leq 2.2V$ sınır değerleri içinde lineer olarak değiştiği görülmüştür.

DC analiz sonucunda, elektriksel işaretin maksimum simetrik salınım yapabilmesi göz önünde tutularak doyma akım ve gerilim sınırları $|I_p| = |I_z| \leq 750\mu\text{A}$, $|V_w| = |V_z| \leq 1.4\text{V}$ olarak belirlenmiştir.



Şekil-2. MOS CDBA Gerçeklemesi

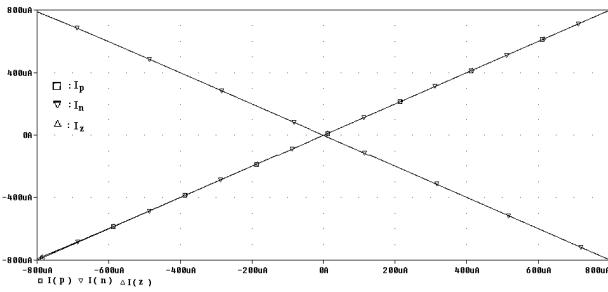
3. PERFORMANS ANALİZİ

Şekil-2'de görülen CDBA devresi ile gerçekleştirilmiş olan çeşitli devrelerin (kuvvetlendiriciler, filtreler vb.) kendilerinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirebilmeleri için, bu devrelerde kullanılan her bir CDBA'nın lineer olarak çalışması gereklidir. Bu nedenle kullanılacak olan CDBA'ların giriş ve çıkışlarına ilişkin akım veya gerilim sınır değerlerinin yani doyma akımlarının ve gerilimlerinin bilinmesi gereklidir. Sınır değerlerin bulunması için bazı test devreleri gerçekleştirilmiş ve bu devrelerin SPICE programı ile DC ve AC analizleri yapılarak CDBA'nın lineer bölgede çalışma koşulları araştırılmıştır.

Şekil-2'de verilen CDBA'nın DC şartlarda davranışını belirlemek için ilk olarak $R_z = 0\Omega$ (kısa devre) ve $I_n = 0A$ yapılmıştır. Bu durumda I_z akımının I_p 'ye göre değişimi incelenmiştir. Bu koşul altında z ucunun

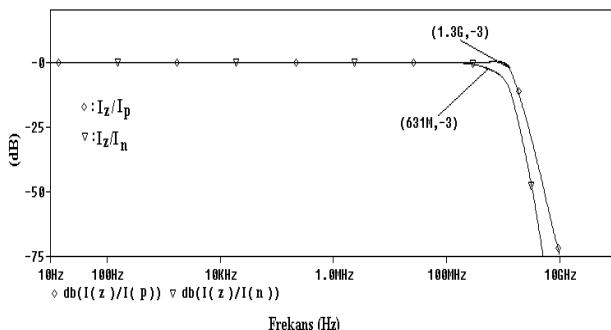
Tablo-1 MOS Tranzistörlerin Parametreleri

| MOS Tranzistor | W/L ($\mu\text{m}/\mu\text{m}$) |
|--|-----------------------------------|
| M1, M2, M11, M12 | 90 / 1.5 |
| M3 – M6, M13 – M16, M21 – M24, M29 – M32 | 60 / 1.5 |
| M7 – M10, M17 – M20, M39, M40 | 120 / 1.5 |
| M33 – M38, M41, M42 | 330 / 1.5 |
| M25 – M28 | 150 / 1.5 |
| M43 | 231 / 1.5 |
| M44 – M47 | 201 / 1.5 |
| M48 – M51 | 504 / 1.5 |
| M52, M58 | 10 / 1.5 |
| M53 | 130 / 1.5 |
| M54, M56 | 41 / 1.5 |
| M59 | 133 / 1.5 |
| M55, M57, M60 | 40 / 1.5 |

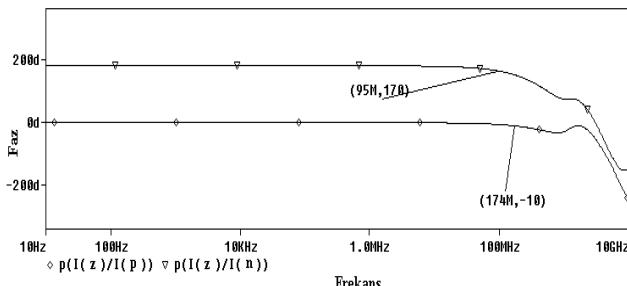


Şekil-3. I_z Akımının I_p 'ye göre ve I_n 'ye Göre Değişimi

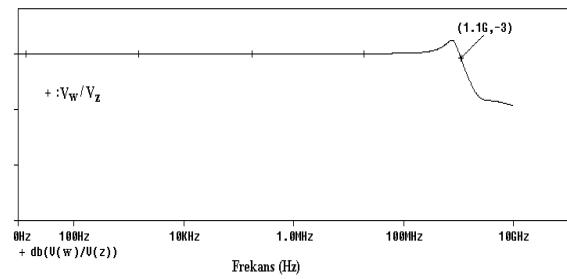
Şekil-2'de görülen CDBA devresinin AC şartlarda davranışlarını belirlemek için, I_z / I_p , I_z / I_n ve V_w / V_z 'nin frekansa göre genlik ve faz değişimleri incelenmiştir. Buna göre elde edilen grafikler Şekil-4, 5,6 ve 7'de verilmiştir. Grafiklerden görüldüğü gibi transfer fonksiyonlarının -3dB zayıfladığı frekans değerleri; I_z / I_p akım transfer fonksiyonu için 1.3GHZ, I_z / I_n akım transfer fonksiyonu için 631MHz ve V_w / V_z gerilim transfer fonksiyonu için 559MHz'dir.



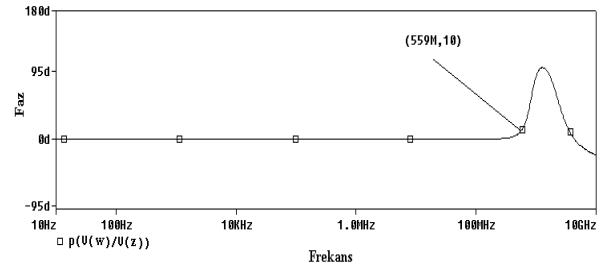
Şekil-4. I_z / I_p ve I_z / I_n 'nin Genlik Karakteristikleri



Şekil-5. I_z / I_p ve I_z / I_n 'nin Faz Karakteristikleri



Şekil-6. V_w / V_z 'nin Genlik Karakteristiği



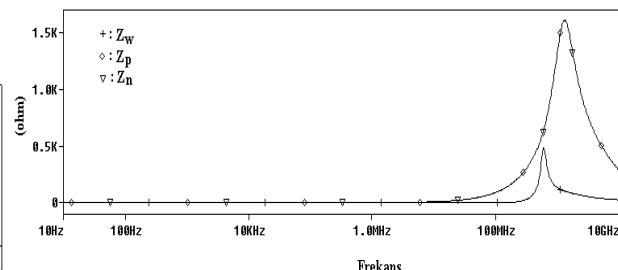
Şekil-7. V_w / V_z 'nin Faz Karakteristiği

Şekil-5 ve Şekil-7'de transfer fonksiyonlarının fazlarının 10° kaydışı frekans değerleri belirtilmiştir. Buna göre devrenin ideale yakın davranışındaki maksimum çalışma frekansı;

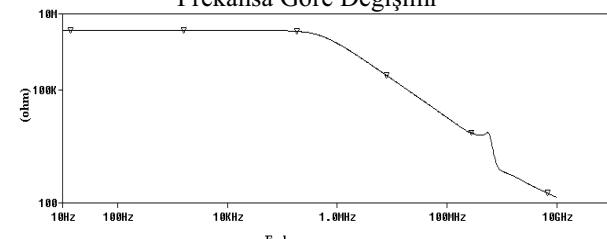
$$f_C = \min\{1300, 631, 95, 559\} \text{ MHz} = 95 \text{ MHz}$$

olarak belirlenir.

Gerçekleştirilen CDBA elemanın giriş ve çıkış empedans değerleri incelendiğinde $Z_p = Z_n = 4.67\Omega$, $Z_w = 4 \text{ m}\Omega$ ve $Z_z = 2.89 \text{ M}\Omega$ olduğu görülmüştür. Empedans değerlerinin frekansa bağlı değişimi Şekil-8 ve Şekil-9'da verilmiştir.



Şekil-8. p , n ve w Uçlarının Empedans Değerlerinin Frekansa Göre Değişimi



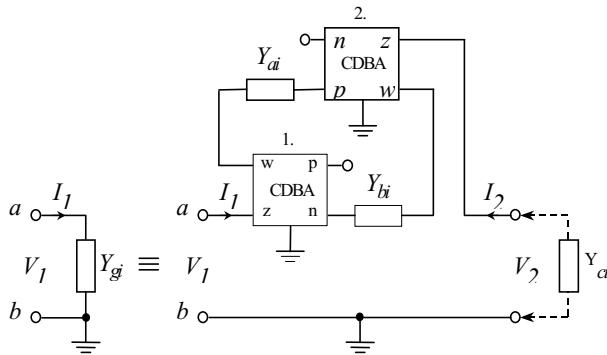
Şekil-9. z Ucunun Empedans Değerinin Frekansa Göre Değişimi

Şekil-3'ten Şekil-9'a kadar verilen eleman karakteristikleri, tasarlanan devrenin iyi bir performans sergilediğini kanıtlamaktadır.

4. UYGULAMA DEVRESİ VE SİMÜLASYON SONUÇLARI

Girişi ve çıkıştı direnç elemanı ile sonlandırılmış basamaklı türden LC devrelerinin düşük duyarlılığı sahip olduğu bilinmektedir [15]. Aktif elemanlarla simülasyonu yapılan devrelerinde aynı şekilde düşük duyarlılığa sahip olacağı beklenmektedir [16].

Şekil-10'da genelleştirilmiş pozitif empedans dönütürücü devresi verilmiştir [2]. Bu devredeki admitanslar yerine Tablo-2'de verilen elemanlar kullanılarak FDNR ve endüktans simülasyonu gerçekleştirilecektir.

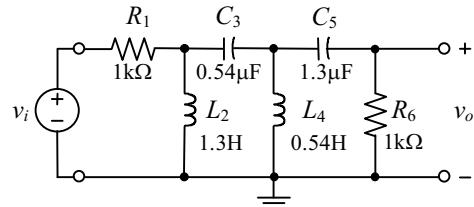


Şekil-10. Genelleştirilmiş Pozitif Empedans Dönüştürücü Devresi

Tablo-2. Y_{ci} ile Sonlandırılmış GPII Devresi.

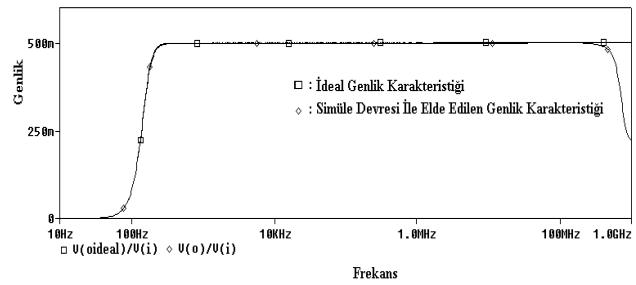
| $Y_a^{(s)}$ | $Y_h^{(s)}$ | $Y_d^{(s)}$ | Sim. Eleman | Değer |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| $\frac{1}{R_i}$ | $\frac{1}{R_j}$ | $\frac{sC}{i}$ | $a \rightarrow b$ | $L_i = R_d R_h C_{di}$ |
| $\frac{sC}{i}$ | $\frac{sC}{h}$ | $\frac{1}{R_i}$ | $a \rightarrow b$ | $D_i = C_d C_h R_d$ |

Uygulama olarak Şekil-11 ile verilen basamaklı türden LC devresinin simülasyonu yapılmıştır. Bu devre dördüncü dereceden Butterworth yüksek geçiren filtre devresidir ve köşe frekansi $f_o = 159\text{Hz}$ 'dir. Şekil-11'deki devrede bulunan bir ucu topraklı endüktansların Şekil-10 ve Tablo-2'deki değerlerden yararlanarak simülasyonu yapılmıştır ve CDBA'lı aktif RC simülle devresi elde edilmiştir.

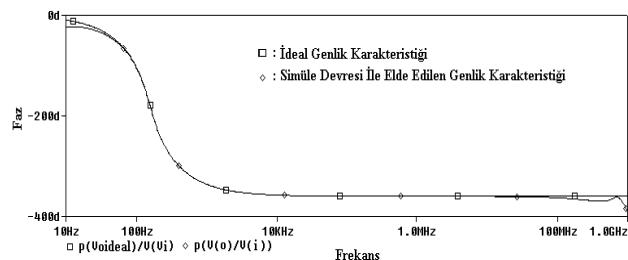


Şekil-11. LC Yüksek Geçiren Filtre Devresi

Şekil-11 ve simülle devrenin SPICE analizi ile elde edilen genlik ve faz karakteristikleri Şekil-12 ve Şekil-13'te verilmiştir.



Şekil-12. Yüksek Geçiren Filtre Devresinin Genlik Karakteristikleri



Şekil-13. Yüksek Geçiren Filtre Devresinin Faz Karakteristikleri

Şekil-12 ve 13'ten de görüldüğü üzere simülle edilen devrenin karakteristikleri ile ideal devrenin karakteristikleri birbirlerine çakıştığı görülmüştür.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, TÜBİTAK YİTAL 1.5 μ parametreleri kullanılarak 95MHz band genişliğinde, $\pm 3\text{V}$ besleme gerilimi ile çalışan CDBA elemanı gerçekleştirilmiş ve elemanın lineer olarak çalıştığı akım, gerilim ve frekans aralıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu devrenin serimi yapılarak tümleştirilmek üzere TÜBİTAK'a gönderilmiştir. Gerçekleştirilen CDBA'nın performansını göstermek için uygulama örneği olarak basamaklı türden yüksek geçiren bir LC devresi seçilmiştir. Gerek LC devresinin ve gerekse simülle devrenin SPICE analiz sonuçlarının çakıştığı görülmüş ve yapılan işlemlerin doğruluğu kanıtlanmıştır.

KAYNAKLAR

- [1] Acar C. and Özoguz S., A New Versatile Building Block: Current Differencing Buffered Amplifier Suitable for Analog Signal Processing Filters., MICROELECTRONICS JOURNAL, vol. 30, pp. 157-160, 1999.
- [2] Özoguz S., Toker A., İbrahim M. A. and Acar C., A New Versatile Building Block: Current Differencing Buffered Amplifier and Its Applications, IN PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN CONFERENCE ON CIRCUIT THEORY AND DESIGN, ECCTD'99, vol. 1, 29 August-2 September 1999, Stresa-Italy, pp. 90-93.
- [3] Özoguz S., Toker A. and Acar C., Current-Mode Continuous-time Fully-integrated Universal Filter Using CDBAs., ELECTRONICS LETTERS, vol. 35, pp. 97-98, 1999.
- [4] Toker A., Özoguz S. and Acar C., Current-mode KHN-equivalent Biquad Using CDBAs., ELECTRONICS LETTERS, vol. 35 (20), pp. 1682-1683, 1999.
- [5] Acar C. and Özoguz S., Nth-order Current Transfer Function Synthesis Using Current Differencing Buffered Amplifier: Signal-Flow Graph Approach. MICROELECTRONICS JOURNAL, vol. 31, pp. 49-53, 2000.
- [6] Özcan S., Kuntman H. And Çiçekoğlu O., Cascadable Current Mode Multipurpose Filters Employing Current Differencing Buffered Amplifier., INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS (AEÜ), vol. 56, no. 2, pp. 67-72, 2002.
- [7] Toker A., Özoguz S., Çiçekoğlu O. and Acar C., Current-mode All-pass Filters Using Current Differencing Buffered Amplifier and a New High-Q Bandpass Filter Configuration., IEEE TRANSACTION ON CIRCUITS AND SYSTEMS-II: ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol. 47, no. 9, pp. 949-954, 2000.
- [8] Acar C. and Sedef H., Realization of nth-order Current Transfer Function Using Current-Differencing Buffered Amplifiers., INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol. 90, no. 4, pp. 277-283, 2003.
- [9] Tangsrirat W., Surakampontorn W. and Fujii N., Realization of Leapfrog Filters Using Current Differential Buffered Amplifiers., IEICE TRANS. FUNDAMENTALS, vol. E86-A, no. 2, pp. 318-326, 2003.
- [10] Salama K. N. And Soliman A. M., Voltage mode Kerwin-Huelsman-Newcomb Circuit Using CDBAs., FREQUENZ, vol. 54, pp. 90-93, 3-4/2000.
- [11] Sedef H. and Acar C., On The Realization of Voltage-Mode Filters Using CDBA., FREQUENZ, vol. 54, pp. 198-202, 9-10/2000.
- [12] Tarim N. and Kuntman H., A High Performance Current Differencing Buffered Amplifier, THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS, October 29-31 2001, Rabat-Morocco, pp. 153-156.
- [13] Özcan S., Toker A., Acar C., Kuntman H. and Çiçekoğlu O., Resistance Controlled Sinusoidal Oscillators Employing Current Differencing Buffered Amplifier., MICROELECTRONICS JOURNAL, vol. 31, pp. 169-174, 2000.
- [14] Toker A., Özoguz S. and Acar C., CDBA-Based Fully-Integrated Gyrator Circuit Suitable for Electronically Tunable Inductance Simulation., INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS (AEÜ), vol. 54, no. 5, pp. 293-296, 2000.
- [15] Orchard H. J., Inductorless Filters., ELECTRONICS LETTERS, 2, pp. 224-225, 1966.
- [16] Senani R., Novel Higher-order Active Filter Design Using Current Conveyors., ELECTRONICS LETTERS, 21, pp. 1055-1056, 1985.